

Физика и техника полупроводников, 2024, том 58, выпуск 6

XXVIII Международный симпозиум "Нанозфизика и нанозлектроника", Нижний Новгород, 11--15 марта 2024 г.

Кукушкин В.А., Кукушкин Ю.В.

Потенциальное быстроедействие алмазного полевого транзистора на приповерхностном двумерном дырочном газе

283

Электронные свойства полупроводников

Давидович М.В.

К электродинамике полупроводниковых магнитоплазмонных волноводов

288

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Марков Л.К., Смирнова И.П., Павлюченко А.С., Яговкина М.А., Аксенова В.В.

Модификация структуры нанокристаллических пленок оксида индия и олова

297

Лебедев М.В., Львова Т.В., Седова И.В., Королева А.В., Жижин Е.В., Лебедев С.В.

Пассивация поверхностей AlGaAs(100) растворами сульфида аммония

302

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Харченко А.А., Надточий А.М., Шерняков Ю.М., Гордеев Н.Ю., Паюсов А.С., Бекман А.А., Корнышов Г.О., Симчук О.И., Салий Ю.А., Кулагина М.М., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Максимов М.В.

Оптическое усиление в волноводных гетероструктурах спектрального диапазона 1010-1075 нм с активной областью на основе InGaAs квантовых яма-точек

313

Бабичев А.В., Надточий А.М., Блохин С.А., Неведомский В.Н., Крыжановская Н.В., Бобров М.А., Васильев А.П., Малеев Н.А., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Егоров А.Ю.

Исследование структурных и оптических свойств InGaAs-квантовых точек

318

Физика полупроводниковых приборов

Кардо-Сысоев А.Ф., Черенёв М.Н., Люблинский А.Г., Смирнова И.А., Юсупова Ш.А.,
Белякова Е.И., Векслер М.И.

**Влияние внешних параметров на процесс переключения при задержанной ионизации
в кремниевой р+-п-п+-структуре**

326

Еремин В.К., Фадеева Н.Н., Вербицкая Е.М., Еремин И.В.

**Физическое обоснование предела временного разрешения кремниевых планарных
детекторов длиннопробежных тяжелых ионов**

333